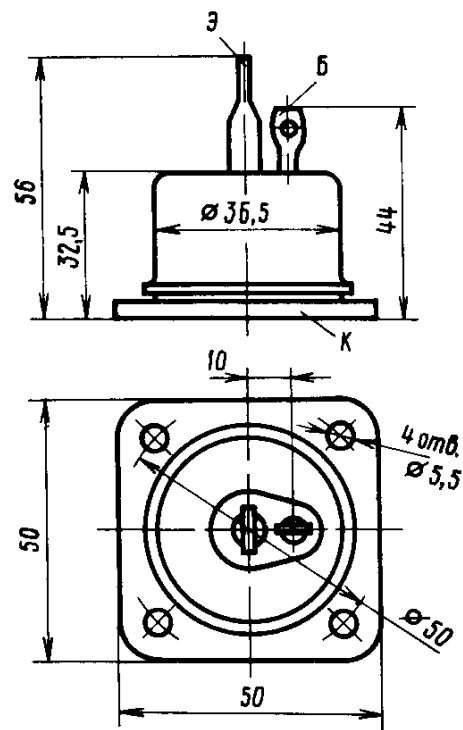
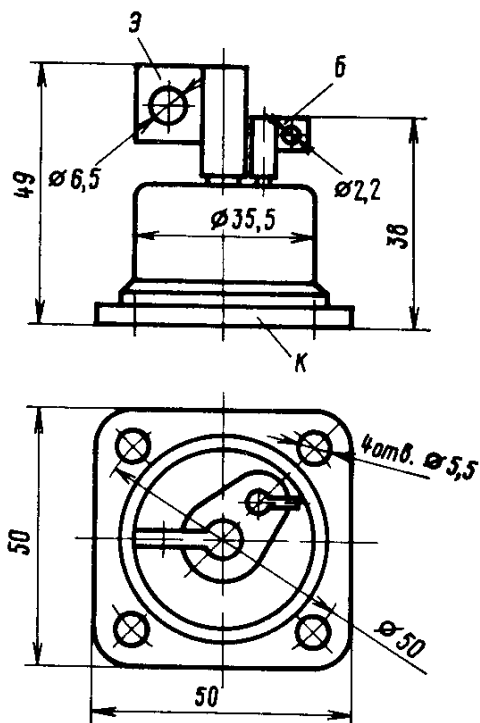


Силовые транзисторы ТКД165-50, ТКД165-63, ТКД165-80, ТКД165-100, ТКД165-125, ТКД165-160, ТКД165-200, ТКД165-250

Транзисторы силовые кремниевые эпитаксиально-мезапланарные предназначены для применения в преобразователях, переключающих и усилительных устройствах, в схемах управления электроприводом и т. д.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ($I_k = 25$ А, $U_{кэ} = 5$ В)	30
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	3 В
Обратный ток коллектор-эмиттер	5 мА
Время включения	2,5 мкс
Время выключения	10 мкс
Тепловое сопротивление переход — корпус	0,09 °С/Вт

Предельно допустимые значения параметров транзисторов

Максимально допустимый импульсный ток коллектора	
ТКД165-50	80 А
ТКД165-63	100 А
ТКД165-80	125 А
ТКД165-100	160 А
ТКД165-125	200 А
ТКД165-160	250 А
ТКД165-200	320 А
ТКД165-250	400 А
Максимально допустимый постоянный ток коллектора	
ТКД165-50	50 А
ТКД165-63	63 А
ТКД165-80	80 А
ТКД165-100	100 А
ТКД165-125	125 А
ТКД165-160	160 А
ТКД165-200	200 А
ТКД165-250	250 А
Максимальная температура корпуса	+125°С
Максимальная температура перехода	+125°С

По максимально допустимому импульсному напряжению коллектор-база транзисторы делятся на девять классов:

Класс	Максимально допустимое напряжение	
	коллектор — эмиттер, В	коллектор-база, В
1	80	200
2	160	300
3	240	400
4	320	500
5	400	600
6	480	700
7	560	800
8	640	900
9	700	1000